

а 2004 0098

Изобретение относится к технологии производства полупроводников, в частности, к способам получения полупроводниковых пористых структур.

Способ получения полупроводниковых пористых структур заключается в том, что на поверхность полупроводника наносят маску, на непокрытые участки имплантируют ионы высокой энергии, затем маску удаляют, а поверхность полупроводника подвергают электрохимическому травлению. Новизна состоит в том, что перед травлением повторно наносят маску только на участки, имплантированные ионами, а на непокрытые участки имплантируют ионы высокой энергии, отличной от предыдущей, и удаляют маску.

П. формулы: 1